直流辉光等离子体放电实验

一. 实验装置:

DH2006 型直流辉光等离子体实验装置

二. 实验目的:

观察直流低气压辉光等离子体的放电现象,通过对辉光等离子体的伏安特性曲线的测量,理解辉光等离子体的电学特性;

理解直流电气击穿的机制;

验证帕邢定律;

采用 Langmuir 双探针法测量等离子体参数。

三. 背景知识:

等离子体作为物质的第四态在宇宙中普遍存在,在实验室中对等离子体的研究是从气体放电开始的。朗缪尔和汤克斯首先引入"等离子体"这个名称。它在工业、农业、国防、医药卫生等领域获得了越来越广泛的应用,为利用受控热核反应,解决能源问题提供了诱人的前景,其主要原因在于等离子体具有两个主要特征:同化学的和其它的方法相比,等离子体具有更高的温度和能量密度;等离子体能够产生活性成分,从而引发在常规化学反应中不能或难以实现的物理变化和化学反应。等离子体作为物质的第四态。近年来等离子体物理学有了较快发展,并被应用于电力工业、电子工业、金属加工和广播通讯等部门,

四. 实验原理:

1. 等离子体及其物理特性及主要参量:

等离子体具有一系列不同于普通气体的特性:

(1) 高度电离,是电和热的良导体,具有比普通气体大几百倍的比热容。(2) 带正电的和带负电的粒子密度几乎相等。(3) 宏观上是电中性的。

描述等离子体的一些主要参量为:

- (1) 电子温度 T_e 。它是等离子体的一个主要参量,因为在等离子体中电子碰撞 电离是主要的,而电子碰撞电离与电子的能量有直接关系,即与电子温度相关联。
- (2) 带电粒子密度。电子密度为 n_e , 正离子密度为 n_i , 在等离子体中 $n_e \approx n_i$ 。

(3) 轴向电场强度 E_{ι} 。表征为维持等离子体的存在所需的能量。(4) 电子平均 动能 E_{ι} 。(5) 空间电位分布。

2. 气体放电

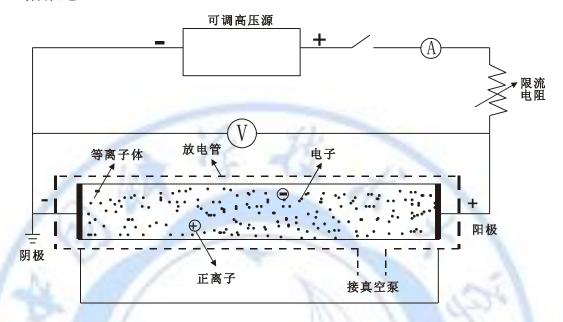


图 1、低气压放电管工作原理示意图

气体放电可以采用多种能量激励形式,如直流、微波、射频等能量形式。其中直流放电因为结构简单、成本低而受到广泛应用。直流放电形成辉光等离子体的经典结构如图(1)所示,在电气击穿形成等离子体前要经历暗放电阶段,包括本底电离区、饱和区、汤森放电区和电晕放电区。

在电极两端施加电压时,通过调节高压源输出电压可得到气体放电的伏安特性曲线,如图 2 所示。由气体放电的伏安特性曲线图可看出,开始在 A、B 点间电流随电压的增加而增加,但此时电流上升变化得较缓慢,表明放电管中气体电离度很小,继续提高电压,电流不再增加,呈本底电离区的饱和状态;继续提高电压,电流会迅速地呈指数关系上升,从 C 到 E 区间,这时电压较高但电流不大,放电管中也无明亮的辉光;自 E 点起,再继续提高电压,发生了新的变化,此时电压不但不增高反而下降,同时在放电管内气体发生了电击穿,观测到耀眼的辉光。这时因电离而电阻减小,但电流开始增长,在 E 点处对应的电压称为气体的击穿电压。放电转变为辉光放电,电流开始上升而电压一直下降到 F 点,然后电流继续上升但电压恒定不变直到 G 点;而后电压随电流的增加而增加到 H 点,放电转入较强电流的弧光放电区。I 和 J 之间是非热弧光区,电流增加电压下降,在 J 和 K 之间是热弧光区,等离子体接近热力学、动力学平衡,从

J 到 K 的弧光放电区属于热等离子特性。

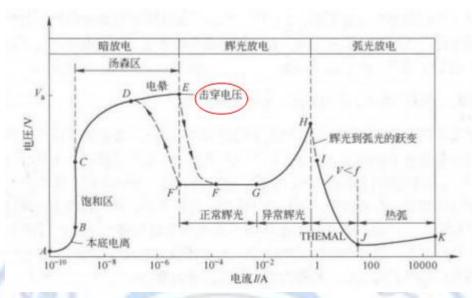


图 2 气体放电伏安特性曲线: AB 段一非自持放电本底电离区; BC 段一非自持放电饱和区; CE 段一汤森放电区; DE 段一电晕放电区; EF 段一前期辉光放电区; FG 段一正常辉光放电区; GH 段一异常辉光放电区; HK 段一弧光放电区

低气压放电可分为三个阶段:暗放电、辉光放电和电弧放电。其中各个阶段的放电在不同的应用领域有广泛的应用。这三个阶段的划分从现象上来看是放电强度的不同,从内在因素来看是其放电电压和放电电流之间存在着显著差异。经典的直流低气压放电在正常辉光放电区有如图 3 所示:

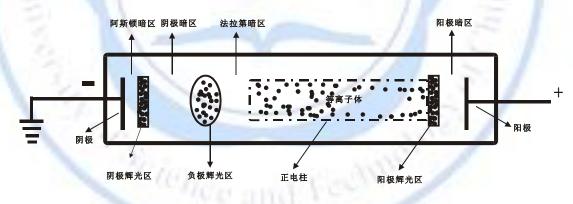


图 3、低气压放电现象

从左至右,其唯象结果如下:

阴极: 阴极由导电材料制成。

阿斯顿(Aston)暗区:紧靠在阴极右边的阿斯顿暗区,是一个有强电场和负空间电荷的薄的区域.它含有慢电子,这些慢电于正处于从阴极出来向前的加速过程中.在这个区域里电子密度和能量太低不能激发气体,所以出现了暗区。

阴极辉光区:紧靠在阿斯顿暗区右边的是阴极辉光区.这种辉光在空气放电

时通常是微红色或桔黄色,是由于离开阴极表面溅射原子的激发,或外部进入的正离子向阴极移动形成的.这种阴极辉光有一个相当高的离了密度.阴极辉光的轴向长度取决于气体类型和气体压力.阴极辉光有时紧贴在阴极上,并掩盖阿斯顿暗区.

阴极暗区:这是在阴极辉光的右边比较暗的区域,这个区域内有一个中等强度电场,有正的空间电荷和相当高的离子密度.

阴极区: 阴极和阴极暗区至负辉光之间的边界之间的区域叫做阴极区. 大部分功率消耗在辉光放电的极区. 在这个区域内. 被加速电子的能量高到足以产生电离, 使负辉光区和负辉光右面的区域产生雪崩.

负辉光区:紧靠在阴极暗区右边的是负辉光区,在整个放电中它的光强度最亮.负辉光中电场相当低,它通常比阴极辉光长,并在阴极侧最强.在负辉光区内。几乎全部电流由电子运载,电子在阴极区被加速产生电离,在负辉光区产生强激发。

法拉第暗区:这个区紧靠在负辉光区的右边,在这个区域里,由于在负辉光区里的电离和激发作用,电子能量很低,在法拉第暗区中电子数密度由于复合和径向扩散而降低。净空间电荷很低,轴向电场也相当小。

正电柱:正电柱是准中性的,在正电柱中电场很小,一般是 1V/cm。这种电场的大小刚好足以在它的阴极端保持所需的电离度。空气中正电柱等离子体是粉红色至蓝色,在不变的压力下,随着放电管长度的增加,正电柱变长。除非触发了自发不动的或运动的辉纹,或产生了扰动引发的电离波,正电柱是一个长的均匀的辉光。

阳极辉光区:阳极辉光区是在正电柱的阳极端的亮区,比正电柱稍强一些,在各种低气压辉光放电中并不总有,它是阳极鞘层的边界.

阳极暗区:阳极暗区在阳极辉光和阳极本身之间,它是阳极鞘层,它有一个负的空间电荷,是在电子从正电柱向阳极运动中引起的,其电场高于正电柱的电场.

3. 帕邢定律

在低气压直流放电中,气体的击穿电压由下式决定:

$$V_b = \frac{cpd}{\ln\left[Apd/\ln\left(1 + \frac{1}{\nu}\right)\right]} = f(pd) \tag{1}$$

其中 γ 为二次电子发射系数,常数 A、C 和气体种类有关的常数,p 为压强, d 为阴阳极间距离,Vb 为击穿电压。

上式表明某一特定气体的击穿电压仅仅依赖于 pd 的乘积,这一现象被称为帕邢(Paschen)定律。

将帕邢定律对 pd 进行微分并使微商等于零,得到最小击穿电压发生时的 pd 值,

$$(pd)_{min} = \frac{e}{A} \ln\left(1 + \frac{1}{\gamma}\right) = \frac{2.718}{A} \ln\left(1 + \frac{1}{\gamma}\right)$$
 (2)

$$V_{b,min} = e \frac{c}{A} \ln \left(1 + \frac{1}{\gamma} \right) = 2.718 \frac{c}{A} \ln \left(1 + \frac{1}{\gamma} \right)$$
 (3)

4. 郎缪尔 (Langmuir) 探针

测试等离子体的方法被称为诊断。等离子体诊断有探针法,霍尔效应法,微波法,光谱法等。本次实验中采用探针法。探针是封入等离子体中的一个小的金属电极(其形状可以是平板形、圆柱形、球形)。以放电管的阳极或阴极作为参考点,改变探针电位,测出相应的探针电流,得到探针电流与其电位之间的关系,即探针伏安特性曲线。要获得理想的伏安特性曲线,探针要满足如下条件:

- (1) 不存在磁场;
- (2) 插入等离子体的探针是平面探针,探针附近的空间电荷鞘层的厚度要远小于探针尺寸:
- (3) 探针的尺寸要小于电子的平均自由程;
- (4) 等离子体满足电中性条件, 鞘层以外的等离子体基本不受探针干扰;
- (5) 探针鞘层中不发生激发和电离:
- (6) 探针材料不会在等离子体中发生化学反应。

探针法分单探针法和双探针法。朗缪尔探针又称为静电探针,是一种双探针结构。双探针法是在放电管中装两根探针,相隔一段距离 L。相比于单探针的诊断方法,双探针不以放电装置的阴极或者阳极作为参考点,而是引入一根与测量

探针完全相同的探针为参考极,从而使两根探针均处于悬浮电位,进而减少了探针对等离子体的扰动,使测量结果更为可靠。

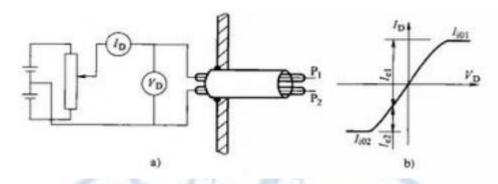


图 4. 双探针测量原理示意图与伏安特性

双探针诊断等离子体示意图如图 4 (a) 所示,它由两根材料、形状、尺寸完全相同的探针 P1 和 P2 构成,其伏安特性如图 4 (b) 所示。双探针的伏安特性曲线要满足如下方程:

$$I_D = I_{i02} - I_{e2} = I_{e1} - I_{i01} (4)$$

$$V_D = V_{P1} - V_{P2} + V_e (5)$$

$$I_{e1} = I_{e01} \exp\left(-\frac{eV_{p1}}{kT_{e1}}\right) \tag{6}$$

$$I_{e2} = I_{e02} \exp\left(-\frac{eV_{p2}}{kT_{e2}}\right) \tag{7}$$

式中, I_{i01} 、 I_{i02} 是探针 1、2 的离子饱和电流; I_{e1} 、 I_{e2} 是电子电流; I_{e01} 、 I_{e02} 是电子饱和电流; V_{p1} 、 V_{p2} 是探针鞘层电位; V_{e} 是两探针间的电位差。

如果两根探针靠得足够近,且等离子均匀,则有 $kT_{e1}=kT_{e2}$, $ne_{01}=n_{e02}$, 由式 $(4)^{\sim}(7)$ 得

$$\frac{I_{e1}}{I_{e2}} = \frac{I_{e01}}{I_{e02}} exp\left(-\frac{eV_{p1} - eV_{p2}}{kT_e}\right) = \frac{I_{e01}}{I_{e02}} exp\left(-\frac{eV_D - eV_e}{kT_e}\right)$$
(8)

对式(8)两边取对数,并对V_D微分后得

$$\frac{1}{I_{e1}} \frac{dI_{e1}}{dV_D} - \frac{1}{I_{e2}} \frac{dI_{e2}}{dV_D} = \frac{e}{kT_e}$$
 (9)

将式(4)代入式(9), 并令 V_D=0 得

$$kT_e = -e \frac{I_{i01}I_{i02}}{I_{i01} + I_{i02}} \left(\frac{dV_D}{dI_D}\right) \Big|_{V_D = 0}$$
(10)

如果两探针完全相同,则 I_{i01} ≈ I_{i02},则有

$$kT_e = -e \frac{I_{i0}}{2} \left(\frac{dV_D}{dI_D} \right) \Big|_{V_D = 0} \tag{11}$$

式(10)和式(11)就是双探针测量电子温度的计算公式。

如果电子能量服从麦克斯韦分布,则单位时间内打在探针单位面积上的电子数为

$$N_e = \frac{1}{4} n_e \bar{u}_e \tag{12}$$

假设探针接受电子的有效面积为 Se, 则探针上接受的饱和电流为

$$I_{e0} = \frac{1}{4}en_e\bar{u}_eS_e \tag{13}$$

电子的平均速度为

$$\bar{u}_e = \sqrt{\frac{8kT_e}{\pi m_e}} \tag{14}$$

由式(13)与式(14)求得电子密度的计算公式为

$$n_e = \frac{4I_{e0}}{eS_e} \sqrt{\frac{\pi m_e}{8kT_e}} \tag{15}$$

式中, I_{e0} 的单位为 A,为了计算方便,取 0.05A; S_{e} 的值取 0.04 cm^{2} ; kT_{e} 的单位为 eV,1eV=11600K,k 为玻尔兹曼常数 k=1.3806505(24)× 10^{-23} J/K; m_{e} 为电子质量 $m_{e}=0$.91× 10^{-30} kg; n_{e} 的单位为 cm^{-3} 。

利用实验数据绘制的双探针 V-I 特性曲线同理论曲线会有很大差距,绘制 V-I 特性曲线时要有足够的数据量,斜率 dV_D/dI_D 取值要注意是在 $V_D=0$ 附近,饱和电流 I_{10} 一般用实验曲线中 I_{101} 和 I_{102} 延长线与纵轴的交点确定。饱和电流 I_{101} 、 I_{102} 、斜率 dV_D/dI_D 的取值如图 5 所示。

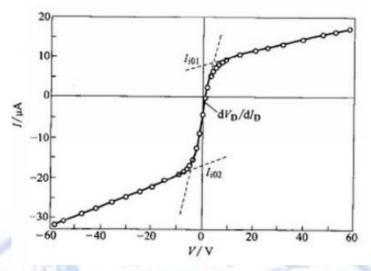


图 5. 双探针法测量电子温度数据曲线

在坐标原点,如果两根探针之间没有电位差,它们各自得到的电流相等,所以外电流为零。然而,一般说来,由于两个探针所在的等离子体电位稍有不同,所以外加电压为零时,电流不是零。如果双探针 V-I 曲线不对称,饱和电流可取正负半轴的平均值再利用式(11)进行计算或直接利用式(10)进行计算,求得电子温度,然后利用式(15)求得电子密度。

五. 实验内容:

- 1. 直流低气压放电现象观察及伏安曲线的测量
 - 1) 了解直流磁控辉光放电等离子体装置的工作原理,观察直流辉光放电现象,并进行分析。辉光放电后要及时把电流调到100mA以下,观察现象时可以把电流调到20mA以下,容易观察到各个放电区。
 - 2) 固定电极距离 120-150 mm,取 2 个不同的工作气压(20,40Pa),测量 辉光放电阶段的放电电压、电流,将测量结果填入下表。注意:起辉时电压会偏高,起辉后及时降电压使电流小于 100 mA,放电打火不稳定时要等一小会,待稳定了再测量,可以从 100mA 附近开始,每降低5mA 左右记录一个电压值,得到 I-V 关系。20Pa 时开始放电电压 700V以上;调节电压会有所滞后,待调节好后 10s 左右读数。
 - 3) 绘制电压-电流曲线,与理论相对照,自主分析其中的差异,并分析原因。分析工作气压对伏安曲线的影响机制。

电极距离:	mm						
					60 Pa (选		
工作气压:	20 Pa	工作气压:	40 Pa	工作气压:	做)		
电压/v	电流/mA	电压/v	电流/mA	电压/v	电流/mA		
		6.20	(23)				
	/	for .	15				
	10	1.3	1-76	-13			
	195			P/4			

表 1、电压、电流测量值

2. 气体击穿电压的测定及帕邢定律的验证

- 1) 掌握击穿电压的测量方法,用击穿电压档,调节电压快到击穿电压时一定要慢,等击穿电压显示值突变(大于 0.5V)同时有放电现象时记录当前放电管电压值。注意:是出现放电现象前一刻的放电管电压值读数,待放电后该读数会减小;放电现象出来后立刻降电压停止放电,再记录击穿前一刻放电管电压,防止电流过大损伤石英管。
- 2) 在保持 d 不变,取 5 个不同的压强 p (10-50Pa),测量对应的气体击穿电压,并作图分析。
- 3. 朗缪尔双探针法测量电子温度和等离子体密度
 - 1) 保持电极距离不变,采用朗缪尔双探针测量 2 组(必做 1 组,另一组选做)探针 I-V 变化数据,保持气压一定(建议 20 Pa),不同功率 (放电电流小于 20mA)。将所得数据填入表 2。注意:0~10 V 间隔 1V, 10-100 V 间隔 10 V;用左边那组靠近正电柱的探针,辉光电流要小(小于 20mA),使正电柱比较明显。
 - 2) 绘制出 I-V 曲线。由曲线斜率根据上述公式计算出电子温度和电子密度。并根据计算结果,分别分析功率(放电管电压*电流)和气压对等离子体参数的影响及影响机理。

功率 W; 气压 Pa			功率 W; 气压 Pa		
电压/V	电流/uA		电压/V	电流/uA	
				- 1	
	1/3		44		
13	13-		12	1	
1/h				4	
10				34	
V				11	
			1		
			300	1130	
1/ 4	058		700		
	200		77.11		

表 2、 不同条件下 V-I 关系数据

4. 定性观测磁场对等离子体辉光的影响,强度、方向、位置等。磁铁线圈 **1000** 匝。(选做)

六. 思考题

- 1. 暗放电区电流的测量应注意什么问题?
- 2. 阴极与阳极显著的热效应差别的原因?
- 3. 磁场和工作气压对辉光放电中的 V-A 特性曲线有何影响? 其影响机制是什么? (选做)

七. 参考资料:

- 1. 竹涛著, 低温等离子体技术处理工业源 VOCs, 冶金工业出版社, 2015. 05
- 2. 张映辉,大学物理实验,机械工业出版社,2010.01
- 3. 林立中,直流辉光等离子体特性研究,福州大学学报,1999.08
- 4. 茅卫红、张慧云、陈宏,低压直流辉光等离子体的放电特性,第六届全国 高等学校物理实验教学研讨会论文集(下),2010

5. 胡明、万树德、钟雷、刘昊、汪海,磁控直流辉光等离子体放电特性,物理学报,2012.04

实验步骤

注意事项:

- 加高压之后千万不能触碰顶端放电的配件,防止触电。
- 不要擅自调节电极距离,如有必要请老师帮忙,调节前前必须把高压调到零, 关闭高压后才能调节。
- 开启高压前要开启冷却水。
- 高压最高加到 1400 V。
- 放电电流小于 100 mA。
- 测击穿电压时,放电后立刻降电压结束放电,再记录击穿前放电管电压,因 为此时不显示放电电流,而实际电流很大。
- 1. 打开电源总开关(在仪器左侧一个气动开关), 拧动仪器钥匙通电。
- 2. 打开机械泵,打开挡板阀(逆时针拧到底),打开电阻真空计,抽本底真空到 <5 Pa。
- 3. 打开流量计到阀控档,调节流量计流量(一般 10sccm 左右,但不同仪器有所不同,可以根据需要调节流量,气压 20Pa),同时观察电阻真空计读数到指定压强。
- 4. 开水冷, 开高压, 并将工作选择打到所需的档位: 内容 1 档位辉光放电测量, 内容 2 档位击穿电压测量, 内容 3 档位探针测量。
- 5. 缓慢调节高压调节旋钮,调节高压大小,根据电流值大小,转换不同的电流 量程。调节有点滞后,测量时要缓慢调节电压。
- 6. 做完一项内容之后,把高压调到零,改变工作选择到所需档位继续测量。不要擅自调节电极距离,如有必要请老师帮忙,调节前必须把高压调到零,关闭高压后才能调节,否则电极带高压很危险。
- 7. 实验结束后把高压调到零,关闭高压,工作选择到断档,关闭冷却水,流量 计打到关闭。待压强低于 5Pa (若抽真空 5min 还未到 5Pa 也可以关闭)再关 闭电阻真空计、挡板阀、机械泵,拧钥匙到关闭档。最后关闭仪器总电源。